

コントラスト変調小角中性子散乱法による カーボンブラック充てん系の構造解析

竹中 幹人^{1*}・西辻祥太郎¹・藤井 澄明¹・網野 直也²・石川 泰弘²・ 山口 大輔³・小泉 智³ Structure Analyses of Swollen Rubber-carbon Black Systems by Contrast Variation SANS

Mikihito TAKENAKA^{1*}, Shotaro NISHITSUJI¹,Sumiaki FUJII¹, Naoya AMINO², Yasuhiro ISHIKAWA²,Daisuke YAM-AGUCHI³ and Satoshi KOIZUMI³(¹Department of Polymer Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto 615-8510,Japan ²The Yokohama-rubber Company, Ltd., 2-1 Oiwaki, Hiratsuka, Kanagawa, 254-8601, Japan ³Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki 319-1195, Japan) *E-mail:takenaka@alloy.polym.kyoto-u.ac.jp

The polymer layers adsorbed on carbon black (CB) aggregates in rubber/CB systems have been investigated with contrast variation small-angle neutron scattering (SANS) method. Specimens were swollen by toluene/deuterated toluene solvents having various scattering length densities and their scattering intensities were measured with SANS. The contrast variation SANS for the specimens yielded partial scattering functions: the scattering function for polymer-polymer correlation $S_{pp}(q)$, the scattering function for CB- CB correlation $S_{cc}(q)$, and the scattering function for polymer- CB correlation $S_{pc}(q)$. The analyses of the partial scattering functions explored the existence of dense polymer layers around CB aggregates. Several characteristic parameters are estimated from the analyses, such as the size of aggregates, the thickness of layers, and the volume fractions of polymer of layers and matrix.

(Received on June 14, 2010)

(Accepted on September 21, 2010)

Key Words: Contrast Variation Small-angle Neutron Scattering, Rubber-filler System, Adsorption Layer, Carbon Black, Partial Scattering Function

1. 緒

言

ゴム充てん系の高性能化において,充てん剤の凝集構造 とともに充てん剤とポリマーの界面領域の構造の解明およ びその性能との相関を明らかにすることは,タイヤの開発 研究における重要な課題である¹⁾.我々は,これまで中性 子・X線散乱法を組み合わせることによって,ミクロン スケールからナノメートルオーダーまでの構造を測定する ことにより,ゴム充てん系の充てん剤の凝集構造を明らか にしてきた^{2,3)}.同様なアプローチを篠原らも超小角X線 散乱法において行ってきている⁴⁾.これらの結果により, 充てん剤が集まって10 nm オーダーの凝集体となり,その 凝集体がマスフラクタル構造を有するネットワーク構造を 形成し,いわゆる階層構造を形成していることが明らかに

¹京都大学工学研究科高分子科学専攻 (〒615-8510 京都市西京区京都大学桂) ²横浜ゴム(㈱タイヤ材料設計部 (〒254-8601 平塚市追分2-1)

³日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター (〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4)

390

されている.この解明によって,充てん系の構造とその力 学的挙動との関係をより明確にすることが可能になったと 考えられる.しかし,力学的挙動はこれらの構造ばかりで はなく,よりミクロな界面の構造にも影響される.

界面領域におけるゴムと充てん剤の接着性はゴム充てん 系の力学的性質に大きな影響を及ぼす.しかしゴムがどの ように充てん剤の表面に吸着しているかは,吸着した層も していないマトリックスの部分もおなじゴムであり散乱の コントラストはないため,バルクの散乱からでは見出すこ とができない.この困難さを解決するために以前の報告に おいて,我々はゴム/シリカ充てん系を散乱長密度の異な る溶媒に膨潤させ,コントラスト変調小角中性子法を用い て散乱の解析を行った^{5,6)}.その結果,シリカ表面におい て表面への強い吸着に伴う膨潤度の低い領域が存在するこ とが見出され,ポリマー吸着層の厚みについて定量的に明 らかにすることができた.

本報告においては、この小角中性子散乱におけるコントラ スト変調法がカーボンブラック(CB)充てん系においても界面 構造の解析に有効な手段であることを明らかにする.

2. 実 験

2.1 試料

本研究では、CB充てん系のゴム成分としてスチレンブ タジエンランダム共重合ゴム (SBR,Nipol1502) を用いた. SBRの分子特性をTable 1に示した. SBR/CB/酸化亜鉛/ ステアリン酸を、それぞれ100/50/3/1の割合で配合し、 1.7Lのバンバリミキサーを用いて5分間混合してマスター バッチを得た.この時,放出時のゴムの温度が150℃にな るように、ミキサーのローター回転数を調整した.続いて 2軸ロール混練機を用いて得られたマスターバッチに加硫 促進剤と硫黄を、SBR100重量部に対してそれぞれ1.5重 量部ずつ添加した. CBは N339ブラックを用いた. 加硫 促進剤として, N-tert-butyl -2-benzothiazyl sulfeneamide (TBBS) を用いた. こうして得られた未加硫ゴ ムを,160℃で50分間プレス加硫し,厚さ1mmのシート 状にした. 作成したサンプルを, 重水素化トルエン (d-tol) とトルエン (h-tol) を様々な体積分率 (d-tol/h-tol = 100/0, 70/30, 50/50, 30/70, 0/100) で混合した溶媒に半日 浸すことにより平衡な膨潤状態に達成させた後、石英セル に溶媒と一緒に装てんして、小角中性子散乱 (SANS) の 測定に用いた.

2.2 SANS 測定

SANS測定は日本原子力研究所のJRR-3Mに設置された 集光型偏極中性子超小角散乱装置(SANS-J-II)において 行った⁷⁾. サンプルーディテクター間距離は測定できる波 数q領域を広げるために2.5mおよび10mの2種類を用い た.用いた波長は $\lambda = 0.65$ nmであり、測定q領域は0.04 <q<0.7 nm⁻¹となった。測定時間は2.5mおよび10mで それぞれ1800sおよび600sであった。測定はすべて室温 で行った。測定されたデータは円環平均後、透過率補正, 空セルの散乱の補正を行った後、アルミの散乱を用いて絶 対強度に変換した。さらに、incoherent scatteringの補正 も行った。

2.3 コントラスト変調小角中性子法

我々は、遠藤らによって開発されたコントラスト変調法 によって各成分の構造解析を試みた⁸⁻¹⁰⁾.前項でも述べた 様に、吸着層はバルクの散乱からでは見出すことができな い.しかし、ゴム充てん系を溶媒で膨潤させることによっ て、もしゴムが充てん剤表面に強く吸着している場合には、

| Table 1 | Characterization | of | SBR |
|----------|--------------------|----|------|
| I abic I | Unar acter ization | O1 | ODIC |

| Polymers | Mw | Mw/Mn | $W_{PS}(\%)^{a}$ | Vinyl content (%) ^b |
|----------|---------------------|-------|------------------|--------------------------------------|
| SBR | 5.0×10^{5} | 3.4 | 23.5 | 15 |

^a Weight fraction of styrene content

^bVinyl content in butadiene sequence

吸着度の分膨潤度が下がる.よって,吸着層と吸着されて いない架橋ゴムのマトリックス層との間に膨潤度の差によ って散乱のコントラストが生じる.このコントラストの差 を用いて吸着層の存在の有無を散乱実験から明らかにする ことができる.

しかし、系がゴム・CB・溶媒の3成分となるため、散 乱のコントラストの空間分布と構造の空間分布の分離が非 常に困難になる.この困難さを解決するために、SANS法 を用いる.SANS法においては、HをDに置き換えること により化学的性質をほとんど変えることなく中性子に対し ての散乱に対するコントラストを変化させることができる¹⁰⁾. よって、膨潤溶媒に重水素化溶媒と非重水素化溶媒の混合 系を用いてその混合比を変えて散乱を測定することによ り、散乱の溶媒の散乱長密度依存性を明らかにすることが できる.この依存性を解析することによって、コントラス トの空間分布と構造の空間分布の分離を行うことができ、 吸着層の構造解析を容易にすることができる.この方法を コントラスト変調小角中性子散乱法という.実際の解析方 法に関しては以下の項において示す.

3. 結果と考察

3.1 SANS プロファイルの d-tol 分率依存性

Figure 1にd-tolとh-tolを様々な比率で混合した溶媒に よって膨潤されたCB充てん系の小角散乱の強度I(q)を 示す.d-tolとh-tolの混合比により溶媒の散乱長密度を変 化させると散乱関数の波数q依存性が変化することが観測 される.qは次式の様に定義される.

 $q = (4 \pi / \lambda) \sin(\theta / 2) \tag{1}$

ここで, *θ*は散乱角である.この*q*依存性の溶媒混合比による変化は,ゴム成分の膨潤度に空間不均一性があるこ



Figure 1 Scattering profiles for SBR-CB system swollen by various composition of d-tol/h-tol. Composition are indicated in the Figure.

と、すなわちCB粒子周りの領域とマトリックス部分では 膨潤度が異なり、吸着層が存在することを示唆する.

3.2 コントラスト変調法による部分散乱関数の計算

この系において加硫促進剤と硫黄の分率はゴム成分・ CB・溶媒よりも非常に少ないため、この系はゴム成分・ CB・溶媒の3成分系とみなすことができる.よってこの 系の散乱関数*I*(*q*) は

$$I(q) = (a_{p} - a_{s})^{2} S_{pp}(q) + (a_{p} - a_{s})(a_{c} - a_{s})S_{pc}(q)$$

$$+ (a_{c} - a_{s})^{2} S_{cc}(q)$$
(2)

で表される⁵⁶⁾. (2) 式において, $a_i t i i d f (i = P : SBR, C : CB, S : トルエン)$ の散乱長密度である. $S_{PP}(q), S_{CC}(q)$ はそれぞれSBR, CBの自己相関に伴う散乱関数, 一方 $S_{PC}(q)$ はSBR-CB間の cross-correlation に伴う部分散乱関数であり, これらは次式で定義される.

$$S_{ij}(q) = \frac{1}{V} \iint \left(\delta \phi_i(\vec{r}) \delta \phi_j(\vec{r}') \right) \exp \left[i \vec{q} \left(\vec{r} - \vec{r}' \right) \right] d\vec{r} d\vec{r}'$$
(3)

(3) 式において、Vは入射光の照射体積、 $\delta\phi_i(\vec{r})$ は成分*i* の場所*r*における体積分率の平均値からのゆらぎであ る. $\Delta a_i = a_i - a_s$ として $\Delta a_i \in i$ (*P* or *C*) とトルエンの散 乱長密度の差(コントラスト)と定義し(2) 式を行列で 書き表すと

$$I(q) = \begin{pmatrix} \Delta a_P^2 & \Delta a_P \Delta a_C & \Delta a_C^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{PP}(q) \\ S_{PC}(q) \\ S_{CC}(q) \end{pmatrix}$$
(4)

となる.各成分の散乱長密度をTable 2に示す.d-tolとhtolの混合比を変化させて a_s の異なる条件でn個の散乱測 定を行うと,波数qにおける散乱関数ベクトル $[I_1(q), I_2(q), \dots I_n(q)]$ は

$$\begin{pmatrix} I_{1}(q) \\ I_{2}(q) \\ \vdots \\ I_{n}(q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{1}\Delta a_{p}^{2} & {}^{1}\Delta a_{p}^{-1}\Delta a_{c} & {}^{1}\Delta a_{c}^{2} \\ {}^{2}\Delta a_{p}^{2} & {}^{2}\Delta a_{p}^{-2}\Delta a_{c} & {}^{2}\Delta a_{c}^{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ {}^{n}\Delta a_{p}^{2} & {}^{n}\Delta a_{p}^{-n}\Delta a_{c} & {}^{n}\Delta a_{c}^{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{pp}(q) \\ S_{pc}(q) \\ S_{cc}(q) \end{pmatrix}$$
(5)

となる. 原理的には*Sij*を求めるためには3種類の異なる 散乱長密度のトルエンを用いて実験を行い,各々*q*におい て3元の連立1次方程式を解けばよい.すなわち,

$$\begin{pmatrix} S_{PP}(q) \\ S_{PC}(q) \\ S_{CC}(q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{1}\Delta a_{P}^{2} & {}^{1}\Delta a_{P}^{-1}\Delta a_{C} & {}^{1}\Delta a_{C}^{2} \\ {}^{2}\Delta a_{P}^{2} & {}^{2}\Delta a_{P}^{-2}\Delta a_{C} & {}^{2}\Delta a_{C}^{2} \\ {}^{3}\Delta a_{P}^{2} & {}^{3}\Delta a_{P}^{-3}\Delta a_{C} & {}^{3}\Delta a_{C}^{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_{1}(q) \\ I_{2}(q) \\ I_{3}(q) \end{pmatrix}$$
(6)

Table 2Scattering length density of each component used in
this study

| | toluene | d-toluene | SBR | СВ |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| $a_i \ (ext{cm}^{-2})$ | 9.41×10 ⁹ | 5.66×10 ¹⁰ | 7.33×10 ⁹ | 6.07×10 ¹⁰ |

として、コントラストのマトリックスの逆行列を散乱のマ トリックスにかければよい.しかし、実験データには誤差 が含まれているため、この方法では精度良く S_{ij} を求める ことができない.そこでデータ点を増やして特異値分解法 により疑似逆行列を求めて S_{ij} を求めること、すなわち、 トルエンの散乱長密度を変化させて行ったn(n>3) 個の 実験より求められる散乱関数のベクトル $[I_1(q), I_2(q), ...$ $I_n(q)]$ と疑似逆行列の積より部分散乱関数を求めること により精度よく部分散乱関数を求めることができる.

$$\begin{pmatrix} S_{pp}(q) \\ S_{pc}(q) \\ S_{cc}(q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{1}\Delta a_{p}^{2} & {}^{1}\Delta a_{p}^{-1}\Delta a_{c} & {}^{1}\Delta a_{c}^{2} \\ {}^{2}\Delta a_{p}^{2} & {}^{2}\Delta a_{p}^{-2}\Delta a_{c} & {}^{2}\Delta a_{c}^{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ {}^{n}\Delta a_{p}^{2} & {}^{n}\Delta a_{p}^{-n}\Delta a_{c} & {}^{n}\Delta a_{c}^{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_{1}(q) \\ I_{2}(q) \\ \vdots \\ I_{n}(q) \end{pmatrix}$$
(7)

Figure 2はFigure 1の散乱関数より特異値分解法を用いて求められた部分散乱関数である.もし吸着層が存在せずに溶媒が均一にSBR相に存在する場合には

 $S_{PC}(q) = -\phi_p S_{CC}(q), S_{PP}(q) = \phi_p^2 S_{CC}(q)$ (8) となる.ここで ϕ_p はSBR (+トルエン)相におけるSBR の体積分率である. $S_{CC}(q)$ はCB粒子の構造関数となる ので必ず正であり,よって吸着層がない場合には $S_{PC}(q)$ が負になると同時に $-S_{PC}(q), S_{CC}(q), S_{PP}(q)$ の形が部分 散乱関数対波数の両対数プロットにおいて同じ形にならな くてはならない.実験結果においてはFigure 2に示す様 に $S_{PC}(q)$ は負になっている.しかし,Figure 3の両対数 プロットに示すように $S_{PP}(q), -S_{PC}(q), S_{CC}(q)$ のq依存 性は小角側で異なっており,溶媒が均一にSBR相を膨潤 していないことを示している.この小角側のq依存性の違 いはSBRの吸着層が存在することによる効果がcross-correlationの項(ターム)に現れていると考えられる.この 傾向は,以前の報告におけるシリカ充てん系の結果と同様



Figure 2 Partial scattering function of SBR-CB systems obtained from scattering profiles from Fig.1.

である.

3.3 部分散乱関数の解析による吸着層の解明

部分散乱関数より吸着層の解明を行うために、シリカ充 てん系の解析を行った場合と同様にCB粒子の周りにSBR の吸着層が存在しているモデル(Figure 4)を考えて部 分散乱関数を導くことにした.CBの凝集構造(領域 α) にSBRの体積分率 ϕ_l の吸着層が(領域 β)存在し、その 周りを体積分率 ϕ_m のマトリックス(領域 γ)が存在する と考えると部分散乱関数は以下の様に表される^{56,12}.

$$S_{CC}(q) = F_{\alpha}(q)^2 \tag{9}$$

$$S_{PC}(q) = (\phi_l - \phi_m) F_{\alpha+\beta}(q) F_{\alpha}(q) - \phi_l F_{\alpha}(q)^2$$
(10)

$$S_{PP}(q) = \left[\left(\phi_l - \phi_m \right) F_{\alpha+\beta}(q) - \phi_l F_\alpha(q) \right]^2$$
(11)

ここで、 $F_{\alpha}(q)$ は領域 α の構造振幅すなわち CB 粒子の凝 集構造の構造振幅、 $F_{\alpha+\beta}(q)$ は領域 α と領域 β 全体の構造



Figure 3 Partial scattering function of SBR-CB systems and their fitting results with model functions (solid lines).

振幅である. CB粒子の凝集構造のモデルとしては,滑ら かな界面を持った慣性半径 $R_{g,a}$ の構造をモデルとして用い た¹³⁻¹⁵⁾. $S_{CC}(q) = S_a(q) = |F_a(q)|^2$ は

$$S_{\alpha}(q) = A \exp\left(-q^2 R_{g,\alpha}^2/3\right) + B\left[\left\{erf\left(qR_{g,\alpha}/\sqrt{6}\right)\right\}^3/q\right]^4 \quad (12)$$

で表される.ここで, *R_{g,a}は凝集構造の慣性半径を示す*. またA, Bはそれぞれ

$$A = KV_c \tag{13}$$

$$B = 2\pi A S_C / V_C^2 \tag{14}$$

であり, *K*,*V_c*,*S_c*はそれぞれ比例乗数, 凝集体の体積, 凝 集体の表面積である.

また領域 α と領域 β を合わせた全体の構造に対しては, 滑らかな界面を持ち,かつ界面領域に界面厚み σ が存在する慣性半径 $R_{g,l}$ の構造をモデルとして用いた¹³⁻¹⁵⁾.この構造の散乱関数 $S_{\alpha+\beta}(q) = |F_{\alpha+\beta}(q)|^2$ は

$$S_{\alpha+\beta}(q) = C \exp\left(-q^2 R_{g,l}^2/3\right) + D\left[\left\{erf\left(qR_{g,l}/\sqrt{6}\right)\right\}^3/q\right]^4 \exp\left(-\sigma^2 q^2\right)$$
(15)

で表される.ここで、
$$C,D$$
はそれぞれ
 $C = KV_i$ (16)

$$D = 2\pi C S_l / V_l^2 \tag{17}$$

であり、 V_l および S_l は領域 α と領域 β を合わせた全体の構造の体積および表面積である.上記の式を用いてフィッティングした結果がFigure 3の実線で示されている.結果は部分散乱関数をよく表しており、モデルの妥当性を示している.フィッティングによって求められた各パラメーターの値をTeble 3に示す.まず、領域 α の慣性半径 $R_{g,\alpha}$ から、CB粒子の凝集構造の大きさ41.4 nmが求められた.領域 α と領域 β を合わせた領域の慣性半径 $R_{g,l}$ がCBの相である領域 α の慣性半径 $R_{g,\alpha}$ よりも大きな値であり、かつ領域 β の高分子の体積分率 ϕ_l が領域 γ の高分子の体積分率 ϕ_m より大きいことがわかる.よってCBの周りには、



Figure 4 Schematic graph of the model of SBR-CB system swollen by solvent.

| $R_{g,a}$ (nm) | $R_{g,l}$ (nm) | t_I (nm) | ϕ_m | ϕ_{l} |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 41.4 | 51.1 | 9.7 | 0.32 | 0.51 |
| А | В | С | D | $\sigma \ (nm)$ |
| 6.47×10 ⁻¹⁸ | 3.28×10 ⁻²⁷ | 3.01×10 ⁻¹⁸ | 5.77×10 ⁻²⁷ | 5.30 |

 Table 3
 Characteristic parameters yielded from fitting

ゴムの吸着層があることが明らかになった.吸着層の厚み $k_{g,l} \geq R_{g,a}$ の差より9.7 nmと求められた.さらに界面厚 み $\sigma = 5.7$ nmが得られたことより領域 β と領域 β の間に 高分子の濃度勾配が存在していることが明らかになった.

以上の結果を以前の研究で測定されたシリカ充てん系と 比較してみる.シリカ充てん系の吸着層の厚みは5.3 nm であり、CB充てん系よりも薄い.また、シリカの凝集構 造(慣性半径32.7nm)はCBの凝集構造より小さくなって いる.もちろんシランカップリング剤の違いやCBの種類 によって大きく異なるとも考えられるので一概にはいえな いが、CB系のほうが厚い吸着層になり、また凝集構造も 大きくなると考えられる.

4.まとめ

カーボンブラック充てん系を重水素化トルエン/トルエ ン混合系による散乱長密度の異なる溶媒に膨潤させ、コン トラスト変調小角中性子散乱法を用いてカーボンブラック 充てん系におけるカーボンブラック凝集体表面におけるゴ ムの吸着層の存在を定量的に明らかにすることを試みた. その結果、カーボンブラックの表面において10 nm 程度の 吸着層が存在することが明らかになった.また、CB粒子 の凝集構造なども明らかにすることができた.今後は CB の種類などによる吸着層の違いなどを明らかにしてゆきた い.

References

- Nippon Gomu Kyokai Ed.; "Shimban Gomu Gijutsu no Kiso", Nippon Gomu Kyokai, Tokyo (2005)
- 2) Koga, T.; Takenaka, M.; Aizawa, K.; Nakamura, M.; Hashimoto, T.: *Langmuir*, **21**, 11409 (2005)
- 3) Koga, T.; Hashimoto, T.; Takenaka, M.; Aizawa, K.; Amino, N.; Nakamura, M.; Yamaguchi, D.; Koizumi, S.: *Macromolecules*, **41**, 453 (2008)
- 4) Shinohara, Y.; Kishimoto, H.; Inoue, K.; Suzuki, Y.; Takeuchi, A.; Uesugi, K.; Yagi, N.; Muraoka, K.; Mizoguchi, T.; Amemiya, Y.: *J.Appl.Cryst.*, 40, s397 (2007)
- 5) Takenaka, M.; Nishitsuji, S.; Amino, N.; Ishikawa, Y.; Yamaguchi, D.; Koizumi, S.: Macromolecules, 42, 308 (2009)
- 6) Takenaka, M.;Nishitsuji, S.; Amino, N.; Ishikawa, Y.; Yamaguchi, D.; Koizumi, S.; Hashimoto, T.: Nippon Gomu Kyokaishi, 81, 334 (2008)
- 7) Koizumi, S.; Iwase, H.; Suzuki, J.; Oku, T.; Motokawa, R.; Sasao, H.; Tanaka, H.; Yamaguchi, D.; Shimizu, H. M.; Hashimoto, T.: J. Appl. Cryst., 40, s474 (2007)
- 8) Endo, H.; Allgaier, J.; Gompper, G.; Jakobs, B.; Monkenbusch, M.; Richter, D.; Sottmann, T.; Strey, R.: *Phys. Rev. Lett.*, **85**, 102 (2000)
- 9) Endo, H.; Mihailescu, M.; Monkenbusch, M.; Allgaier, J.; Gompper, G.; Richter, D.; Jakobs, B.; Sottmann, T.; Strey, R.; Grillo, I.: *J.Chem.Phys.*, **115**, 580 (2000)
- 10) Endo, H.; Schwahn, D.; Cölfen, H.: J.Chem.Phys., **120**, 9410 (2004)
- Miyazaki, S.; Endo, H.; Karino, T.; Haraguchi, K.; Shibayama, M.: Macromolecules, 40, 4287 (2007)
- 12) Koubunshi Gakkai Ed.: "Shin Koubunshi Jikkengaku 6 Koubunshi no Kouzou (2)", Kyoritsu-Shuppan, Tokyo (1997)
- 13) Beaucage, G.; Schaefer, D.W.: J. Non-Crystal.Solids, **172**, 797 (1994)
- 14) Beaugcage, G.: J.Appl.Cryst., 29, 134 (1996)
- 15) Beaugcage, G.: J.Appl.Cryst., 28, 717 (1995)

日本語表記参考文献

- 1) 日本ゴム協会編:新版ゴム技術の基礎(改訂版),日本ゴム協会 (2005)
- 6) 竹中幹人,西辻祥太郎,網野直也,石川泰弘,山口大輔,小泉智,橋 本竹治:日本ゴム協会誌,81,334 (2008)
- 12)新高分子実験学第6巻高分子の構造(2)共立出版,東京,第 3章(1997)

* *

* * *